

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年6月11日(2015.6.11)

【公開番号】特開2013-12730(P2013-12730A)

【公開日】平成25年1月17日(2013.1.17)

【年通号数】公開・登録公報2013-003

【出願番号】特願2012-120782(P2012-120782)

【国際特許分類】

H 01 L	21/8234	(2006.01)
H 01 L	27/06	(2006.01)
H 01 L	21/822	(2006.01)
H 01 L	27/04	(2006.01)
H 01 L	27/088	(2006.01)
H 01 L	27/08	(2006.01)
H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/768	(2006.01)
H 01 L	23/522	(2006.01)

【F I】

H 01 L	27/06	1 0 2 A
H 01 L	27/04	A
H 01 L	27/04	D
H 01 L	27/04	C
H 01 L	27/08	1 0 2 E
H 01 L	27/08	3 3 1 E
H 01 L	29/78	6 1 3 Z
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 6 T
H 01 L	21/90	D

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月20日(2015.4.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1のトランジスタと、第2のトランジスタと、容量素子と、を有し、前記第1のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方は、前記第2のトランジスタのゲートに電気的に接続され、

前記第2のトランジスタの上方に、前記第1のトランジスタ及び前記容量素子が配置され、

前記第1のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と、前記容量素子の一方の電極と、を兼ねる共通電極を有し、

前記共通電極の上方に、前記容量素子の他方の電極が配置されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】

請求項1において、

前記共通電極と前記第2のトランジスタのゲートとは、前記第1のトランジスタの半導体層に設けられた開口部を介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】

第1のトランジスタと、第2のトランジスタと、容量素子と、を有し、

前記第1のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方は、前記第2のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方に電気的に接続され、

前記第2のトランジスタの上方に、前記第1のトランジスタ及び前記容量素子が配置され、

前記第1のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と、前記容量素子の一方の電極と、を兼ねる共通電極を有し、

前記共通電極の上方に、前記容量素子の他方の電極が配置されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項4】

請求項3において、

前記共通電極と前記第2のトランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方とは、前記第1のトランジスタの半導体層に設けられた開口部を介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一項において、

前記第1のトランジスタの半導体層と、前記第2のトランジスタの半導体層と、は重なる位置に配置されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか一項において、

前記第1のトランジスタのゲートと前記共通電極とは、前記容量素子の他方の電極の上方に設けられた配線を用いて電気的に接続され、

前記配線と前記共通電極とは、前記容量素子の他方の電極に設けられた開口部を介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】

トランジスタと、容量素子と、を有し、

前記トランジスタのソース電極又はドレイン電極の一方と、前記容量素子の一方の電極と、を兼ねる共通電極を有し、

前記共通電極の上方に、前記容量素子の他方の電極が配置されており、

前記トランジスタのゲートと前記共通電極とは、前記容量素子の他方の電極の上方に設けられた配線を用いて電気的に接続され、

前記配線と前記共通電極とは、前記容量素子の他方の電極に設けられた開口部を介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。